

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

ведущего научного сотрудника

в лаборатории оптики кристаллов и гетероструктур с экстремальной двумерностью.

Вакансия VAC 135994

Тематика исследований

Разработка технологии выращивания методом молекулярно-пучковой эпитаксии их исследование многослойных квантоворазмерных гетероструктур в системе соединений (Al,Ga,In)As

Трудовая деятельность

- Проведение научных исследований в рамках реализации научных программ в области физики и технологии полупроводников и физики конденсированных сред согласно государственному заданию, выполнение работ по проектам с различными российскими и зарубежными научными фондами, а также по программам Минобрнауки и других министерств и ведомств РФ в соответствии с задачами лаб. оптики кристаллов и гетероструктур с экстремальной двумерностью.
- Участие в написании и подаче конкурсных заявок на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- Руководство технологической группой молекулярно-пучковой эпитаксии, формирование планов проведения экспериментов по выращиванию эпитаксиальных структур методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Общая координация и непосредственное участие в проведении регламентных и срочных работ по техническому обслуживанию установки молекулярно-пучковой эпитаксии.
- Координация деятельности соисполнителей, в том числе и из других организаций и лабораторий, участвующих в совместном выполнении работ, для достижения целей НИР и ОКР в рамках компетенции, анализ и обобщение полученных результатов.
- Экспериментальное исследование процессов выращивания методом молекулярно-пучковой эпитаксии многослойных и квантово-размерных гетероструктур в системе соединений (Al,Ga,In)As, в том числе и использованием метаморфных буферных слоёв.
- Определение конкретных диапазонов условий роста методом молекулярно-пучковой эпитаксии гетероструктур различного типа и назначения в системе соединений (Al,Ga,In)As.
- Анализ и обобщение полученных результатов исследования выращенных гетероструктур методами структурной и оптической характеристики, нахождение корреляции физических свойств изучаемых материалов и структур с параметрами технологического процесса, в том числе путем анализа научной литературы.
- Написание научно-технических отчетов по выполняемым НИР и ОКР.
- Разработка и оформление комплектов технологической документации, требуемых при выполнении НИР и ОКР.
- Подготовка заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, написание патентных отчетов.
- Инициация и подготовка публикаций в научных журналах, издаваемых в России и за рубежом, индексируемых базами данных WoS, Scopus, РИНЦ. Выступление с докладами на научных семинарах и конференциях.
- Подготовка и повышение квалификации научных кадров, руководство работой магистров и аспирантов.

Требования к кандидату

- Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности «Физика и технология материалов и компонентов электронной техники» или смежной.
- Наличие ученой степени кандидата или доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников» или смежной.
- Стаж научной работы по специальности не менее 20 лет.
- Опыт работы в области технологии молекулярно-пучковой эпитаксии полупроводников не менее 15 лет.
- Наличие не менее 100 публикаций в рецензируемых научных изданиях (в т. ч., не менее 20 за последние 5 лет в изданиях, индексируемых БД WoS/ScopusDB).
- Наличие публикаций в высокорейтинговых журналах (Q1 и/или Q2)
- Наличие индекса Хирша по БД WoS или ScopusDB не ниже 18.
- Участие с устными докладами на российских и международных конференциях.
- Опыт выполнения и руководства научно-исследовательскими проектами.
- Опыт руководства коллективом группы исследователей, в т. ч. научного руководства аспирантами и магистрами/специалистами по программам высшего образования.
- Опыт подготовки и написания патентных заявок и разработки комплектов технологической документации.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 48 000 руб.

СТАВКА: 1.0

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении учёной степени
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, учёному секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45